

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION
PUBLIC RELATIONS DIVISION
7-3, Marunouchi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokio, 100-8310, Japan

ZUR SOFORTIGEN VERÖFFENTLICHUNG

Nr. 3085

Bei diesem Text handelt es sich um eine Übersetzung der offiziellen englischen Version dieser Pressemitteilung, die nur als Hilfestellung und Referenz bereitgestellt wird. Ausführliche und/oder spezifische Informationen entnehmen Sie bitte der englischen Originalversion. Im Falle von Abweichungen hat der Inhalt der englischen Originalversion Vorrang.

Kundenanfragen

Power Device Overseas Marketing Dept. A und Dept. B
Mitsubishi Electric Corporation

www.MitsubishiElectric.com/semiconductors/

Presseanfragen

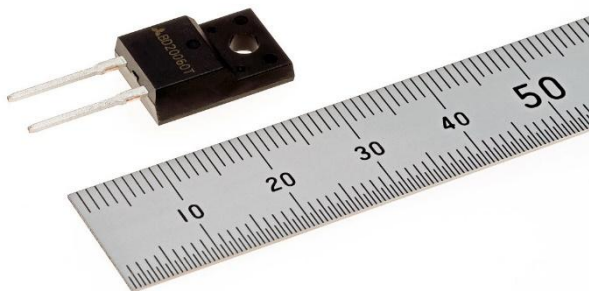
Public Relations Division
Mitsubishi Electric Corporation
prd.gnews@nk.MitsubishiElectric.co.jp

www.MitsubishiElectric.com/news/

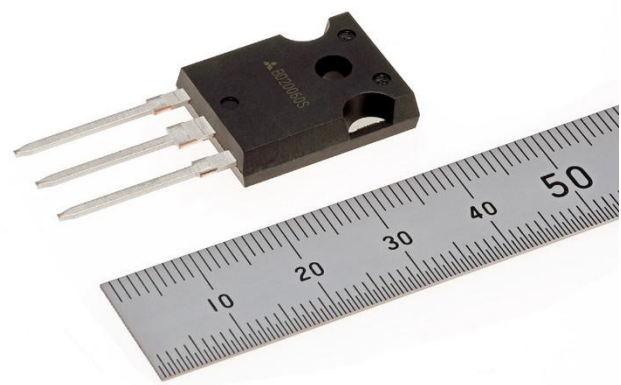
Mitsubishi Electric führt Siliciumcarbid-Schottky-Dioden ein

Geringerer Energieverlust und Platzersparnis bei Stromanlagen

TOKIO, 1. März 2017 – [Mitsubishi Electric Corporation](http://www.MitsubishiElectric.com) (TOKIO: 6503) hat heute die sofortige Einführung einer Siliciumcarbid-Schottky-Diode (SiC-SBD) angekündigt, in der eine Schottky-Diodenstruktur zum Einsatz kommt, um den Energieverlust und die physische Größe von Stromanlagen für Klimatechnik-, Photovoltaik- und andere Systeme zu verringern.



SiC-SBD (BD20060T)



SiC-SBD (BD20060S)

Produktmerkmale

1) *Siliciumcarbid trägt zu niedrigerem Stromverbrauch und kompakter Bauform bei*

- Die verbesserte Energieumwandlung führt zu einem um circa 21 % niedrigeren Energieverlust im Vergleich zu Produkten mit Silicium (Si)
- Hochfrequenzschaltungen und die Verkleinerung von Peripheriekomponenten wie Reaktoren werden möglich

2) *Bessere Zuverlässigkeit dank der Schottky-Diodenstruktur*

- Kombination der Schottky-Diode mit p-n-Übergang
- Die Schottky-Diodenstruktur hilft, hohe Zuverlässigkeit zu erreichen

Zeitplan für den Verkauf

Serie	Modell	Gehäuse	Spezifikation	Lieferung
SiC-SBD	BD20060T	TO-220	20 A/600 V	01. Mrz. 2017
	BD20060S	TO-247		01. Sep. 2017

Hauptspezifikationen

Modell	BD20060T	BD20060S
Spezifikation	20 A/600 V	
Nicht periodischer Stoßstrom	155 A (8,3 ms, Sinuswelle)	
Diodendurchlassspannung	1,35 V	
Gehäuse	TO-220	TO-247
Maße	10,1×29,0×4,7 mm	15,9×41,0×5,0 mm

Mitsubishi Electric trägt seit der ersten Kommerzialisierung eines Leistungsmoduls mit SiC-Elementen im Jahr 2010 fortlaufend zur Miniaturisierung von Wechselrichtersystemen und zur Erhöhung ihrer Energieeffizienz bei. Die Nachfrage nach energieeffizienten Stromanlagen für Klimatechnik-, Photovoltaik- und andere Systeme steigt, da Verbraucher sich immer öfter für Produkte mit SiC-SBDs entscheiden.

Umweltbewusstsein

Diese Produkte entsprechen den Vorgaben der Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten (RoHS).

Hinweis: Die Entwicklung dieser Produkte wurde teilweise von der japanischen New Energy and Industrial Technology Development Organization (NEDO, Organisation für neue Energien und Industrietechnologie) unterstützt.

###

Über die Mitsubishi Electric Corporation

Mit über 90 Jahren Erfahrung in der Bereitstellung zuverlässiger, hochwertiger Produkte ist die Mitsubishi Electric Corporation (TOKIO: 6503) ein anerkanntes, weltweit führendes Unternehmen in der Herstellung, in der Vermarktung und im Vertrieb von Elektro- und Elektronikgeräten für die Informationsverarbeitung, Kommunikation, Raumfahrtentwicklung und Satellitenkommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrietechnik, den Energie- und Transportsektor sowie Gebäudeanlagen. Im Sinne seiner Unternehmensphilosophie „Changes for the Better“ und Umwelterklärung „Eco Changes“ setzt sich Mitsubishi Electric als globales, im Umweltschutz führendes Unternehmen dafür ein, die Gesellschaft mit neuen Technologien zu bereichern. Das Unternehmen verzeichnete konzernweit einen konsolidierten Umsatz von 4.394,3 Mrd. Yen (38,8 Mrd. US-Dollar*) im Geschäftsjahr zum 31. März 2016. Weitere Informationen erhalten Sie unter:

www.MitsubishiElectric.com

* Zum Wechselkurs von 113 Yen für einen US-Dollar, der am 31. März 2016 von der Tokioter Devisenbörse angegeben wurde.